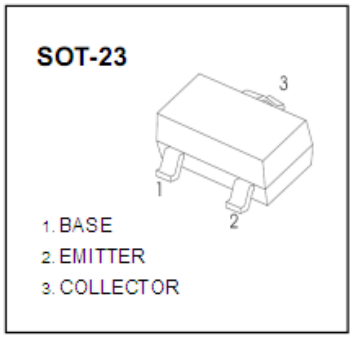
SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

S9012（ PNP ）

印章/Marking：2T1



特点/Features：

h_{FE} 线性特性好；

用途/Applications：

用于功率放大电路，与 S9013 互补。

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	-0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	℃
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55～150	℃

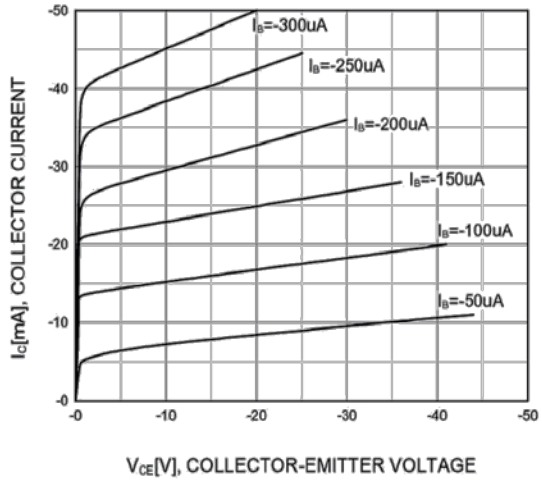
电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	I_C=-100μA, I_E=0	-40			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	I_C=-1mA, I_B=0	-25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	I_E=-100μA, I_C=0	-5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	V_{CB}=-40V, I_E=0			-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	V_{EB}=-5V, I_C=0			-0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CEO}	V_{CE}=-20V, I_B=0			-0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	V_{CE}=-1V, I_C=-50mA	120		400	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	I_C=-500mA, I_B=-50mA			-0.6	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	I_C=-500mA, I_B=-50mA			-1.2	V
特征频率	f_T	V_{CE}=-6V, I_C=-20mA, f=30MHz	150			MHz
输出电容	C_{ob}	V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz			5	pF

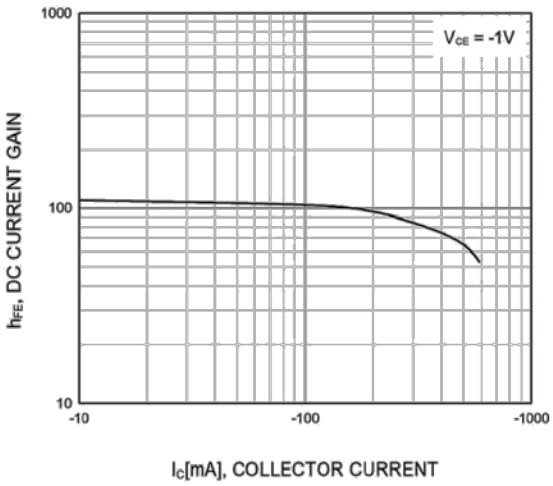
h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

档位/Rank	L	H	J
范围/Range	120～200	200～350	300～400

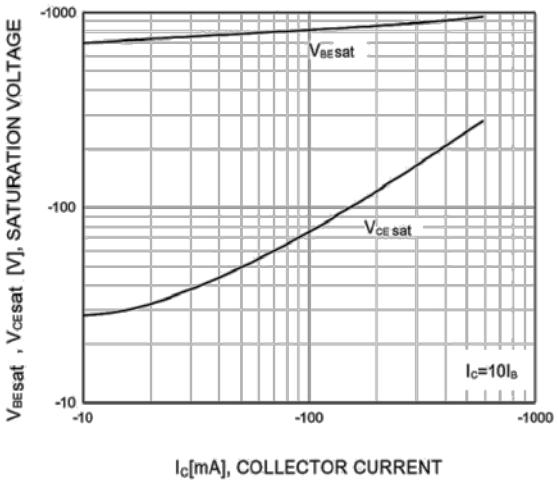
典型特性曲线图/Typical Characteristics



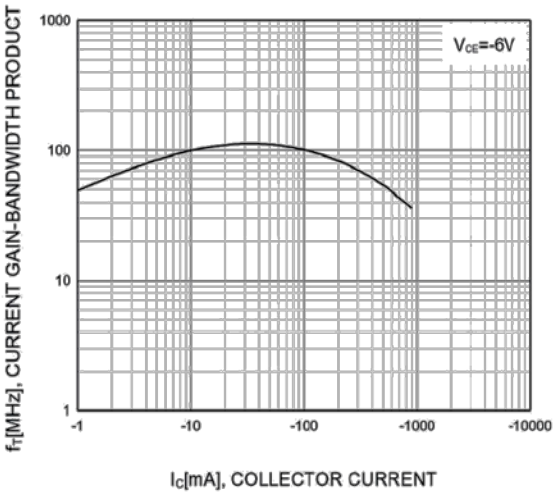
Static Characteristic



DC current Gain



Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product